

制，其卓越性能与高集成度单片式双级同步整流设计，内部集成一个超低导通阻N沟道的MOSFET以

设计在非连续开关模式(DCM)下，内部集成N沟道MOSFET具有低开启阈值电压、超低导通电阻、超快开关特性，同时支持零电压关断，具备超短恢复时间。

用在输出为5V标准的反激控制的开关电源系统，作为次级整流二极管。S7302S能有效降低次级功率损耗，内部电路通过检测MOSFET的VDS变化产生一个理想的驱动信号来控制内部MOSFET，非常适合应用于手机充电器，S7302S将为客户提供优异的解决方案。

P-8封装。

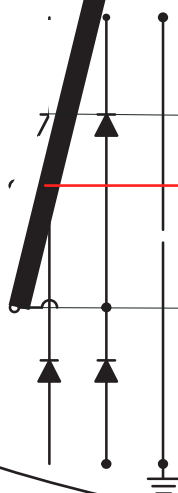
特点

- 支持非连续模式 (DCM)
- 支持准谐振模式 (QRM)
- 内部集成高性能功率MOSFET
- 高度集成，只需极少外围器件

应用范围

- 充电器和适配器的同步整流
- 反激式控制器
- 输入电压5V2A或2.4

SOP-8封装



订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	备注
S7302S	SOP-8	-40°C ~ 105°C	卷盘 4000 颗/盘	S7302S XXXXXXX XXXXXXX

引脚封装

